



三洋半導体
ニュース

No. 1624
8064

STK4893

厚膜混成集積回路

40W min 2チャンネルAFパワーアンプ(2電源)



- 特長
- ・エミッタフォロフ回路を内蔵し 高級化を図っている。
 - ・ケース温度 125 °C を保証し 放熱板の大幅削減ができる。
 - ・ミュートング回路を外付けすることにより 電源 オン、オフ時のショックノイズをなくすることができる。

最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$	± 46	V
熱抵抗	θ_{j-c}	1.6	$^\circ\text{C}/\text{W}$
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
動作時 IC 基板温度	T_C	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	$-30 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	t_s	$V_{CC} = \pm 32\text{V}, R_L = 8\Omega, P_O = 40\text{W}, f = 50\text{Hz}$	2 sec

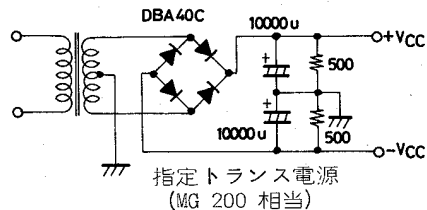
推奨動作条件 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
推奨電源電圧	V_{CC}	± 32	V
負荷抵抗	R_L	8	Ω

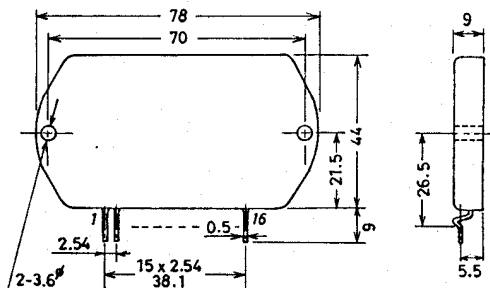
動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{CC} = \pm 32\text{V}, R_L = 8\Omega$ (無誘導), $R_g = 600\Omega, V_G = 40\text{dB}$, 指定測定回路(応用回路例に準ずる)において。

			min	typ	max	unit
無信号電流	I_{COO}	$V_{CC} = \pm 38.5\text{V}$	35	70	120	mA
出力電力	$P_O(1)$	THD=0.02%, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$	40			W
	$P_O(2)$	$V_{CC} = \pm 29\text{V}, \text{THD} = 0.08\%, R_L = 4\Omega, f = 1\text{kHz}$	45			W
全高調波ひずみ率	THD	$P_O = 1\text{W}, f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$			0.02	%
周波数特性	f_L, f_H	$P_O = 1\text{W}, \pm 0_{-3}\text{dB}$		10~100k		Hz
入力抵抗	r_i	$P_O = 1\text{W}, f = 1\text{kHz}$		90k		Ω
出力雑音電圧	V_{NO}	$V_{CC} = \pm 38.5\text{V}, R_g = 10\text{k}\Omega$			1.2	mVrms
出力中点電圧	V_N	$V_{CC} = \pm 38.5\text{V}$	-70	0	+70	mV

- (注)
- ・検査時の電源には 指定のないかぎり定電圧電源を使用する。
 - ・負荷短絡許容時間 および 出力雑音電圧の測定は 右図の指定トランス電源を使用する。
 - ・出力雑音電圧は平均値指示型実効値目盛(VT VM)のピーク値を示す。ただし AC 電源は AC 1 次側ラインのフリッカ性ノイズの影響をなくするため AC 安定化電源(50 Hz)を使用する。



外形図 4029 (unit: mm)



* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

